

Presupuesto	
Número de pieza	FDMS0312AS
Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 30V 18A PT8
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	47731 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	3V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	8-PQFN (5x6)
Serie	PowerTrench®, SyncFET™
RDS (Max) @Id, Vgs	5 mOhm @ 18A, 10V
La disipación de energía (máximo)	2.5W (Ta), 36W (Tc)
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	8-PowerTDFN
Otros nombres	FDMS0312ASTR
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Tiempo de entrega estándar del fabricante	26 Weeks
Estado sin plomo / Estado RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	1815pF @ 15V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	31nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Descripción detallada	N-Channel 30V 18A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 36W (Tc)
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	18A (Ta), 22A (Tc)

Usted también puede estar interesado

FDMS0312AS

Palabra clave

Más

relacionada

FDMS0312AS

AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Hoja de datos FDMS0312AS

Hojas de datos FDMS0312AS

FDMS0312AS PDF

AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMS0312AS

FDMS0312AS electrónico

Componentes FDMS0312AS

Distribuidor FDMS0312AS

Parte FDMS0312AS

Precio FDMS0312AS

Fabricante FDMS0312AS

Imagen FDMS0312AS

Inventario FDMS0312AS

FDMS0312AS Nuevo

FDMS0312AS Original

FDMS0312AS garantizado

FDMS0312AS RFQ

FDMS0312AS Orden en línea